

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4271915号
(P4271915)

(45) 発行日 平成21年6月3日(2009.6.3)

(24) 登録日 平成21年3月6日(2009.3.6)

(51) Int.CI.	F 1
H05B 33/06 (2006.01)	H05B 33/06
H05B 33/10 (2006.01)	H05B 33/10
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14 A
G09F 9/30 (2006.01)	G09F 9/30 365Z
H01L 27/32 (2006.01)	

請求項の数 7 (全 17 頁)

(21) 出願番号 特願2002-252296 (P2002-252296)
 (22) 出願日 平成14年8月30日 (2002.8.30)
 (65) 公開番号 特開2005-108437 (P2005-108437A)
 (43) 公開日 平成17年4月21日 (2005.4.21)
 審査請求日 平成17年3月16日 (2005.3.16)
 (31) 優先権主張番号 特願2002-109682 (P2002-109682)
 (32) 優先日 平成14年4月11日 (2002.4.11)
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(73) 特許権者 000103747
 オプトレックス株式会社
 東京都荒川区東日暮里五丁目7番18号
 (74) 代理人 100103894
 弁理士 家入 健
 (72) 発明者 中村 伸宏
 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番
 地 旭硝子株式会社中央研究所内

審査官 松田 慶之

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】有機エレクトロルミネセンス表示素子、有機エレクトロルミネセンス表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

相対する第1の導電性層と第2の導電性層と、
 当該第1の導電性層に、補助配線を介して電気的に接続された駆動回路接続端子と、
 当該第1の導電性層と当該第2の導電性層との間に設置された有機エレクトロルミネセンス層と
 を有する有機エレクトロルミネセンス表示素子であって、

当該補助配線が、当該駆動回路接続端子と接する層が特定の数量のNbを含有した第1Mo合金層と、当該第1の導電性層と接する層が特定の数量のNbを含有した第2Mo合金層と、第1Mo合金層と第2Mo合金層との間に配置されたA1-Nd層の3層から少なくとも構成され、

前記第1の導電性層の前記補助配線と接続される部位がA1またはA1合金を含んでい
 る

有機エレクトロルミネセンス表示素子。

【請求項2】

前記駆動回路接続端子がITOよりなる請求項1に記載の有機エレクトロルミネセンス表示素子。

【請求項3】

前記第2の導電性層がITOよりなる請求項1または2に記載の有機エレクトロルミネセンス表示素子。

【請求項 4】

前記特定の数量のNb含有量は5～20原子%である請求項1、2または3に記載の有機エレクトロルミネセンス表示素子。

【請求項 5】

前記第1の導電性層の前記第2M〇合金層と接続された部分が、絶縁膜により画定されている請求項1～4のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネセンス表示素子。

【請求項 6】

前記補助配線が30本以上の配線数を有する請求項1～5のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネセンス表示素子。

【請求項 7】

請求項1～6のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネセンス表示素子とこの有機エレクトロルミネセンス表示素子を駆動するための駆動回路とを含んでなる有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【発明の詳細な説明】**【0001】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、有機発光材料を用いた表示素子である有機エレクトロルミネセンス（有機EL）表示素子およびこの素子を用いた表示装置である有機エレクトロルミネセンス（有機EL）表示装置に関する。

【0002】**【従来の技術】**

近年の情報通信分野における急速な技術開発の進展に伴い、CRTに代わるフラットディスプレイに大きな期待が寄せられている。なかでも有機ELディスプレイは、高速応答性、視認性、輝度などの点に優れるため盛んに研究が行われている。

【0003】

1987年に米国コダック社のTangらによって発表された有機EL素子は、有機薄膜の2層積層構造を有し、発光層にトリス（8-キノリノラト）アルミニウム（以下「Alq」と略称する）を使用し、10V以下の低電圧駆動で緑色の発光を生じ、1000cd/m²と高輝度が得られた。発光効率は1.5ルーメン/Wであった（Appel. Phys. Lett., 51, 913 (1987)）。

【0004】

以降、急速に実用化に向けた研究が進められ、正孔注入電極と電子注入電極に挟まれた有機層が1層～10層程度の様々な積層型の有機EL素子が開発されてきている。

【0005】

有機EL材料に関しても、多岐に渡る低分子化合物を真空蒸着法等により薄膜形成する方法のみならず、高分子系化合物をスピンドルコート法、インクジェット、ダイコート、フレキソ印刷といった方法で薄膜形成して有機EL素子を作成する方法が提案されている。

【0006】

なお、特許庁のホームページに、「技術分野別特許マップ作成委員会」によって作成された有機EL素子に関する技術情報が掲載されており、いわゆる基本特許や、さまざまな材料、製法、デバイス構造、駆動方法、カラー化技術、耐久性向上、用途などに関し、特許出願公開や登録特許などを引用し統括的に報告が行なわれている。

【0007】

ところで、有機EL表示装置は電流駆動素子を使用しており、パッシブ駆動型有機EL表示装置では、各行が選択された時間内で瞬間発光する必要がある。その結果液晶デバイス等の電圧駆動型表示素子を使用する場合と比較して大電流が電極に流れ込むことになる。

【0008】

たとえば、画素サイズが300μm×300μmで、陽極本数が100本のパネルを1

10

20

30

40

50

/ 64 デューティー比で駆動する場合、発光効率が 1 cd / A であると、平均輝度 300 cd / m²で点灯させる際、選択期間内に陰極に流れ込む電流は 172.8 mA となる。一方、電圧駆動素子を使用する液晶表示装置では、このような過大な電流が流れることはない。

【0009】

そこで、陰極と駆動回路接続端子との間はこの電流による電圧上昇を抑制するため、陰極が低抵抗の陰極補助配線に接続され、電流が陰極補助配線から駆動回路接続端子に至る構造になっている。

【0010】

しかしながら、パネルの大型化、高精細化、高輝度化が進むと陰極補助配線の更なる低抵抗化が必要となってくると同時に、この陰極と陰極補助配線とのコンタクトや駆動回路接続端子と陰極補助配線との低抵抗化が課題となって来ている。10

【0011】

特に、陰極と陰極補助配線とのコンタクト特性は低抵抗だけでなく、流れる電流によりコンタクト部で発生するジュール熱に対しても安定であること、つまりジュール熱によりコンタクト抵抗が上昇しにくいことが必要であり、より厳しいコンタクト性能が必要とされる。ジュール熱によりコンタクト抵抗が上昇するのは、陰極補助配線等に使用されている金属の酸化によるものと考えられている。

【0012】

従来技術による陰極と陰極補助配線とのコンタクト構造を図 8 に示す。図 8 において、ガラス等よりなる透明基板 1 上には、陽極 2a と駆動回路接続端子 2b とが設けられている。20

【0013】

駆動回路接続端子 2b は、陰極補助配線 3 を介して陰極 7 と電気的に接続されている。そして、陽極 2a と陰極 7 との間に電流を供給することによって、有機 EL 層 6 が発光する。絶縁膜 4 は、有機 EL 層 6 と陽極 2a とが接触する部位 4a を画定する役割を有している。

【0014】

このような構造においては、通常、陽極 2a には ITO (酸化インジウム - 酸化スズ) が、陰極には Al、Mg、Ag 等の酸化されやすい金属が使用される。そして、陰極補助配線については Cr 等の金属を用いている。30

【0015】

この場合、たとえば膜厚 300 nm、幅 150 μm、長さ 4 mm、比抵抗 20 μ cm の Cr パターンを用いると、その抵抗値は 17.7 となり、上述のような電流を流した場合には 3.1 V 程度の電圧降下が配線抵抗に応じて生じ、所望の電位より上昇することになる。

【0016】

また図 8 に示したとおり、陰極補助配線 3 には、製造の工程を経るにしたがって、図 8 中に示すような酸化層 3a が形成され、これにより陰極 7 と陰極補助配線 3 とのコンタクト抵抗が上昇してしまう。40

【0017】

そして、これらの電圧上昇は、階調表示時の表示ムラや、使用する陽極ドライバの耐圧上昇などの悪影響を及ぼすものと考えられる。

【0018】

これに関し、たとえば、有機 EL 表示素子の陰極補助配線について、特開平第 11-317292 号公報に開示された技術がある（従来例 1）。この従来例 1 では、駆動回路接続端子に透明電極材料を用い、かつ、陰極材料と陰極補助配線材料とを同一とする。この場合、陰極材料と陰極補助配線材料との接続前に陰極表面や陰極補助配線表面が酸化されなければ、陰極と陰極補助配線とのコンタクト抵抗の問題は解消する可能性が大きくなる。

【0019】

しかしながら、一般的に有機EL表示素子では、陰極は酸化しやすい材料を用いる一方、透明電極材料はITOのような金属酸化物を適用する。

【0020】

このため、陰極補助配線を陰極と同一材料とする場合には、有機EL表示素子の製作過程やその後の使用中に、陰極補助配線と、透明電極材料を使用する駆動回路接続端子とのコンタクト部で陰極補助配線の金属が酸化され、コンタクト抵抗が上がってしまうという問題が生じる。

【0021】

特に高温で保持した場合に、コンタクト抵抗の上昇は顕著であり、陰極および陰極補助配線にAlあるいはAl合金を、駆動回路接続端子にITOを適用した場合には、100程度の保持で、コンタクト抵抗が著しく上昇してしまう。

10

【0022】

また、特開平第11-329750号公報（従来例2）には、陰極と陰極補助配線とのコンタクト抵抗を低減するための技術が開示されている。従来例2では、陰極補助配線を下地パターンと電極パターンとの2つに分けて形成し、下地パターンにTiNあるいはCrを適用し、電極パターンにAlを適用して、陰極とコンタクトさせることで、低抵抗なコンタクト特性が得られるとしている。

【0023】

しかしながら、この技術では、コンタクト抵抗の問題を論じる前に、陰極補助配線形成に2回のフォトリソ工程が必要となり、しかもTiNにおいてはパターニングにドライエッチングを適用する必要があり、生産性に問題がある。

20

【0024】

また下地パターンにCrを用いた場合には、初期コンタクト特性が良好な場合であっても、100程度の高温に放置した場合には、コンタクト抵抗が著しく上昇することがあり、信頼性上の問題が残る。

【0025】**【発明が解決しようとする課題】**

本発明では、低抵抗であり、つまり使用初期から低抵抗であり、陰極および駆動回路接続端子に対してその低コンタクト抵抗を維持でき、かつ、信頼性のあるコンタクト特性を有する陰極補助配線を有する有機EL表示素子および有機EL表示装置を提供することを目的とする。

30

【0026】**【課題を解決するための手段】**

本発明の態様1は、相対する第1の導電性層と第2の導電性層と、当該第1の導電性層に、補助配線を介して電気的に接続された駆動回路接続端子と、当該第1の導電性層と当該第2の導電性層との間に設置された有機エレクトロルミネセンス層とを有する有機エレクトロルミネセンス表示素子であって、当該補助配線が、当該駆動回路接続端子と接する層が特定の数量のNbを含有した第1Mo合金層と、当該第1の導電性層と接する層が特定の数量のNbを含有した第2Mo合金層と、第1Mo合金層と第2Mo合金層との間に配置されたAl-Nd層の3層から少なくとも構成され、前記第1の導電性層の前記補助配線と接続される部位がAlまたはAl合金を含んでいる有機エレクトロルミネセンス表示素子を提供する。

40

【0027】

本発明の態様2は、前記駆動回路接続端子がITOよりなる請求項1に記載の有機エレクトロルミネセンス表示素子を提供する。

【0028】

本発明の態様3は、前記第2の導電性層がITOよりなる前記態様1または2に記載の有機エレクトロルミネセンス表示素子を提供する。

【0029】

50

本発明の態様 4 は、前記特定の数量のNb含有量は5～20原子%である請求項1、2または3に記載の有機エレクトロルミネセンス表示素子を提供する。

【0030】

本発明の態様 5 は、前記第1の導電性層の前記第2Mo合金層と接続された部分が、絶縁膜により画定されている請求項1～4のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネセンス表示素子を提供する。

【0031】

本発明の態様 6 は、前記補助配線が30本以上の配線数を有する請求項1～5のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネセンス表示素子を提供する。

【0032】

本発明の態様 7 は、請求項1～6のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネセンス表示素子とこの有機エレクトロルミネセンス表示素子を駆動するための駆動回路とを含んでなる有機エレクトロルミネセンス表示装置を提供する。

【0033】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明の実施の形態を図、実施例等を使用して説明する。なお、これらの図、実施例等および説明は本発明を例示するものであり、本発明の範囲を制限するものではない。本発明の趣旨に合致する限り他の実施の形態も本発明の範疇に属し得ることは言うまでもない。

【0034】

たとえば、下記の説明で陽極と陰極とを入れ替えた構造もあり得る。また、以下の説明では、補助配線を形成する積層金属膜として、特定の数量のNbを含有したMo合金層、A1-Nd層、特定の数量のNbを含有したMo合金層の3層よりなる場合について説明しているが、両側の特定の数量のNbを含有したMo合金層の組成は互いに異なっていてもよい。さらに、内側に他の金属層が存在していてもよい。

【0035】

一般的には、A1-Nd層や陰極を構成する材料はかなり厳重に管理された工程であっても容易に酸化される場合が多いので、陰極と接続される側の特定の数量のNbを含有したMo合金層の方が、駆動回路接続端子と接続される側の特定の数量のNbを含有したMo合金層より重要である場合が多い。

【0036】

なお、補助配線が、A1-Nd層を有することが好ましいのは、低抵抗化が容易であり、また高い信頼性が得られるからである。

【0037】

コンタクト抵抗の上昇は、有機EL表示素子の製造工程において起こる場合と、有機EL表示素子の使用中に起こる場合がある。

【0038】

完成した有機EL表示素子のコンタクト抵抗の上昇を経時的に観察した場合、初期値は、製造工程において起こるコンタクト抵抗の上昇分を含んだ値であり、その後のコンタクト抵抗の上昇が、使用中に起こる上昇である。

【0039】

なお、本発明に言う有機EL表示装置は、後述する如く、陽極、駆動回路接続端子、有機EL層、陰極を主要素とする有機EL表示素子に、駆動用回路、駆動用電源、ケーシング、付属装置等を含めて構成されるのが一般的である。

【0040】

図中、同一の部分については同一の符号を付すものとする。

【0041】

図1は、本発明に係る有機EL表示素子の一例の平面図を示す。図2は図1のA-A'断面である。また、図9は本発明に係る有機EL表示素子の一例の作成順序を示すフロー図である。

10

20

30

40

50

【0042】

以下、図1, 2を参照しつつ、図9のステップの順に従って説明する。

【0043】

まず、ステップS₁に従って、シリカコート層を有するガラス基板1のシリカコート層上に導電性層を成膜する。この導電性層は上記における第2の導電性層に該当する。

【0044】

ガラス基板としては、たとえばソーダライムガラスを使用することができる。

【0045】

シリカコート層の厚さは通常10~30nmであり、たとえばスパッタリング法によって成膜することができる。

10

【0046】

なお、この導電性層は透光性を有するのが一般的である。透光性を有するとは、いわゆる透明導電性層の場合のように光の透過率が90~100%と高い場合以外に、ある程度の透明性を有する場合も含み得ることを意味する。透明導電性層であることが好ましい。表示素子としての機能を充分に発揮できるからである。

【0047】

導電性層の厚さは通常50~200nmである。より好ましくは100~150nmである。典型的には、DCスパッタ法により作製したITO膜である。この説明ではITO膜を使用する。

【0048】

導電性層は、一般的には、このほか、真空蒸着法、イオンプレーティング法等の物理的気相成長法(PVD)で作製することができる。

20

【0049】

ついで、ステップS₂に従って、フォトリソ工程でレジストをパターニングし、その後ステップS₃に従って、ITO膜をエッチングし、ついでステップS₄に従ってレジストを剥離し、陽極パターン2aおよび駆動回路接続端子2bを得る。

【0050】

レジストとしては、本発明の趣旨に反しない限り、公知のどのようなものを使用してもよい。エッチングには、たとえば塩酸および硝酸の混合水溶液を使用することができる。レジストの剥離についても、本発明の趣旨に反しない限り、公知のどのような剥離剤を使用してもよい。

30

【0051】

その後、ステップS₅に従って、たとえばDCスパッタ法により、順に、特定の数量のNbを含有したMo合金層、A1-Nd層、特定の数量のNbを含有したMo合金層を成膜する。このようにして形成された積層金属膜は、本発明に係る補助配線3である。

【0052】

積層金属膜は、このほか、真空蒸着法、イオンプレーティング法等の物理的気相成長法(PVD)、電解めっき、無電解めっき等のめっき法で作製することができる場合がある。

【0053】

40

特定の数量のNbを含有したMo合金層の厚さは、通常50~200nmであり、A1-Nd層の厚さは、通常200~400nmである。特定の数量のNbを含有したMo合金を用いると耐腐食性が向上する。このため、Mo合金としては、2成分系のMo-Nb、を用いることが好ましい。

【0054】

A1-Ndを適用する場合には、ヒロックの発生を抑制する。また、A1-Ndを使用するとキュア時に低抵抗化できる点で好ましい。

【0055】

ここでは、Mo-Nb層、A1-Nd層、Mo-Mb層の3層の組み合わせを使用することとする。

50

【0056】

その後、ステップS₆に従って、フォトリソ工程でレジストをパターニングし、ついで、ステップS₇に従って、積層金属膜をエッチングし、ステップS₈に従って、レジストを剥離する。この場合のレジストも、本発明の趣旨に反しない限り、公知のどのようなものを使用してもよい。

【0057】

エッチングには、たとえば磷酸、酢酸、硝酸の混合水溶液よりなるエッチング液を使用することができる。レジストの剥離についても、本発明の趣旨に反しない限り、公知のどのような剥離剤を使用してもよい。

【0058】

M₀-Nb層およびAl-Nd層はこのエッチング液で一括エッチングが可能である。これにより陰極補助配線パターン3が形成される。

10

【0059】

なお、上記のITO膜のパターニング工程(ステップS₂～S₄)と積層金属膜のパターニング工程(ステップS₆～S₈)の代わりに、ITO膜と積層金属膜とをスパッタ法で順に成膜し、その後積層金属膜とITO膜とをこの順番でパターニングすることも可能である。

【0060】

その後、ステップS₉に従って、絶縁膜として、たとえば感光性ポリイミド膜をスピニコートィングし、ステップS₁₀に従ってフォトリソ工程でパターニングを行った後、ステップS₁₁に従ってキュアし、図1，2に示すように、画素部に画素開口部4aを有する絶縁膜パターン4を得る。

20

【0061】

キュア後の絶縁膜パターン4の膜厚は、通常1.0μm程度である。

【0062】

画素開口部が300μm×300μm程度の場合、陰極と補助配線とのコンタクト形成部4bを200μm×200μm以下とすると、素子全体の大きさに影響を与えて済むため好ましい。

【0063】

その後、ステップS₁₂に従って、たとえば感光性アクリル樹脂をスピニコートし、フォトリソ工程でパターニングを行った後、キュアし、陰極分離パターン5を得る。

30

【0064】

本パターンでは、逆テーパー構造を有するようネガタイプの感光性樹脂を用いることが好ましい。ネガタイプの感光性樹脂を用いると、上から光を照射した場合、深い場所ほどキュアが不十分となり、その結果、上から見た場合、硬化部分の断面積が、上方より下方の方が狭い構造を有し、横から見ると図10の構造を生じる。これが逆テーパー構造を有するという意味である。

【0065】

このような構造にすると、その後陰極のマスク蒸着時に上から見て陰になる部分8には蒸着が及ばないため陰極同士を分離することが可能となる。

40

【0066】

なお、上記の感光性ポリイミド樹脂、感光性アクリル樹脂は、相互に互換可能である場合もある。また、本発明の趣旨に反しない限り、エポキシ樹脂、フェノール系樹脂等公知のどのような絶縁膜用樹脂を使用することも可能である。

【0067】

その後、ステップS₁₃に従って、たとえば、並行平板RFプラズマ(高周波プラズマ)装置を用い、酸素プラズマ照射を実施して、ITO膜の表面改質を行い、ついで、ステップS₁₄に従って、たとえば蒸着装置を用い、有機EL層と陰極とをマスク蒸着する。この陰極は本発明に係る第1の導電性層に該当する。

【0068】

50

有機EL層は、界面層、正孔輸送層、発光層、電子注入層等を構成要素とすることが多い。ただし、これとは異なる層構成を有する場合もあり得る。有機EL層の厚さは、通常100～300nmである。

【0069】

なお、本絶縁膜パターンの形成により、陽極2aの端部は絶縁膜で覆われる。このため、有機EL層が陽極2aに接する面が平坦化され、電界集中等による有機EL層あるいは陰極の断線の可能性が減少し、陽極と陰極との絶縁耐圧が向上する。

【0070】

これに対し、図11に示すように、陽極エッジ9が有機EL層と接するようになると、電界集中等による有機EL層あるいは陰極の断線の可能性が生じ、好ましくない。

10

【0071】

陰極にはAlを使用することが多いが、その代わりにLi等のアルカリ金属、Ag、Ca、Mg、Y、Inやそれらを含む合金を用いることも可能である。陰極の厚さは、通常50～300nmである。なお、特定の数量のNbを含有したMo合金層とのコンタクト特性を考慮すると、AlあるいはAl合金を含んでいることが好ましい。

【0072】

AlやAl合金には酸化しやすいものが多く、補助配線を形成する材料が酸化された場合、その酸化物中の酸素がAlやAl合金に拡散するおそれが生じるが、特定の数量のNbを含有したMo合金層の表面に生じる酸化物はそのような酸素のマイグレーションを起こしにくいこと、特定の数量のNbを含有したMo合金層の酸化物が良導体に属すること等によるものと推察される。

20

【0073】

なお、陰極のすべてがAlあるいはAl合金を含んでいる必要はなく、導電性層が前記補助配線と接続される部位がAlまたはAl合金を含んでいればよい。

【0074】

陰極は、このほか、スパッタリング、イオンプレーティング法等の物理的気相成長法(PVD)で作製することができる場合がある。

【0075】

これにより、有機EL層よりなる有機ELパターン6および陰極パターン7が形成される。そして、低抵抗であり、陰極および駆動回路接続端子に対して低コンタクト抵抗を維持でき、かつ、信頼性のあるコンタクト特性を有する陰極補助配線を有する有機EL表示素子およびこの有機エレクトロルミネセンス表示素子とこれを駆動するための駆動回路とを含んでなる有機EL表示装置を得ることが可能となる。

30

【0076】

具体的には、上記積層金属膜により低抵抗が実現し、駆動回路接続端子2bと陰極補助配線3との間のコンタクト抵抗および、陰極パターン7と陰極補助配線3との間のコンタクト抵抗を低い値に維持することができる。

【0077】

さらに、本発明は、補助配線が30本以上の配線数を有し、このため電力消費量が大きく、従来の有機EL表示素子ではコンタクト抵抗の劣化の大きい場合に効果が大きい。

40

【0078】

通常想定される画素サイズ300μm×300μm、陽極本数100本、電流効率1cd/A、輝度300cd/m²を考慮した場合、1/30デューティー比で陰極本数が30本以上であると陰極に流れ込む電流は50mAを超える。そして、補助配線の本数(配線数)は陰極本数と同じであるから、補助配線に流れ込む電流は50mAを超えることになる。

【0079】

一方、従来補助配線として使用されているCr等の金属材料およびコンタクトサイズ200μm×200μmの場合、200μm×200μm当たりの電力消費量が200mW程度を超えるときには、それによって発生する熱により、コンタクト金属の剥離、変質が

50

発生し、コンタクト抵抗の劣化が生じる場合が多い。

【0080】

ところが、上記のような条件では、従来補助配線として使用されている金属材料のコンタクト抵抗が $200\text{ }\mu\text{m} \times 200\text{ }\mu\text{m}$ 当たり5程度となり、電力消費量が 250 mW となる。

【0081】

従って、低コンタクト抵抗であり、その値を維持できる補助配線を使用する本発明は、このような状況において特に有用であると言える。

【0082】

なお、本発明に用いる構成部材、たとえば上記の導電性層、有機EL層、レジスト、剥離剤、絶縁膜用樹脂等には、上記した材料の外、本発明の趣旨に反しない限り、たとえば、「有機EL材料とディスプレイ」（シーエムシー社発行）などに記載されている従来公知の材料を用いることができる。10

【0083】

【実施例】

次に本発明の実施例を詳述する。例1，2は参考例である。

【0084】

[例1]

上記の説明に従って、有機EL表示素子を作製した。各工程の内容は、特記しない限り、上記と同様である。20

【0085】

まず、スパッタリングによって成膜した 20 nm のシリカコート層を有する厚さ 0.7 mm のソーダライムガラス基板1のシリカコート層上に、DCスパッタ法により、 150 nm のITO膜を成膜した。

【0086】

その後、フォトリソ工程でレジストをパターニングし、その後塩酸および硝酸の混合水溶液を用いて、ITO膜をエッチングし、ついでレジストを剥離して、陽極パターン2aおよび駆動回路接続端子2bを得た。

【0087】

レジストとしてはフェノールノボラック樹脂を使用し、レジスト剥離剤としてはモノエタノールアミンを使用した。30

【0088】

その後、DCスパッタ法により、順にMo層、Al-Nd層、Mo層よりなる積層金属膜を成膜した。この積層金属膜の膜厚は下部Mo層が 100 nm 、Al-Nd層が 300 nm 、上部Mo層が 100 nm とした。

【0089】

その後、フォトリソ工程でレジストをパターニングし、ついで、磷酸、酢酸、硝酸の混合水溶液よりなるエッチング液を用いて、積層金属膜をエッチングしてからレジストを剥離した。これにより陰極補助配線パターン3が形成された。レジストとしてはフェノールノボラック樹脂を使用し、レジスト剥離剤としてはモノエタノールアミンを使用した。40

【0090】

その後、絶縁膜4として、ポリイミド膜を $1.4\text{ }\mu\text{m}$ の厚さでスピンドルコートィングし、フォトリソ工程でパターニングを行った後、 320°C でキュアし、図1，2に示すように、画素部に画素開口部4aを有する絶縁膜パターン4を得た。

【0091】

またこのキュアにより、上記Al-Nd層の抵抗を低くすることができた。これは、キュアの熱でNdがAlの粒界に移動するためと考えられている。

【0092】

画素開口部を $300\text{ }\mu\text{m} \times 300\text{ }\mu\text{m}$ 、陰極と補助配線とのコンタクト形成部4bを $200\text{ }\mu\text{m} \times 200\text{ }\mu\text{m}$ とした。50

【0093】

キュア後の絶縁膜パターン4の膜厚は1.0 μmであった。

【0094】

その後、感光性アクリル樹脂をスピンドルコートし、フォトリソ工程でパターニングを行った後、200 °Cでキュアし、陰極分離パターン5を得た。ネガタイプの感光性樹脂を用いた。

【0095】

その後、並行平板RFプラズマ装置を用いて、酸素プラズマ照射を実施して、ITO膜の表面改質を行い、ついで、蒸着装置を用いて、有機EL層と陰極とをマスク蒸着した。

【0096】

具体的には、酸素流量50 sccm（標準状態で50 mL/min），ガスの合計圧力6.7 Pa，1.5 kWのプラズマ処理条件でRIE（反応性イオンエッティング）モードのプラズマ処理を60秒実施した。

【0097】

その後、銅フタロシアニン（以下、CuPcという）よりなる界面層，N,N'-ジ（ナフタレン-1-イル）-N,N'-ジフェニル-ベンジジン（以下、-NPDという）よりなる正孔輸送層，Alqよりなる発光層，LiFよりなる電子注入層，Alよりなる陰極を、それぞれ、10 nm, 60 nm, 50 nm, 0.5 nm, 200 nm成膜した。

【0098】

このうち、CuPcよりなる界面層，-NPDよりなる正孔輸送層，Alqよりなる発光層，LiFよりなる電子注入層とで、有機EL層が形成される。

【0099】

正孔輸送層について、-NPDの代わりにトリフェニルジアミン（以下、TPDという）などのトリフェニルアミン系の物質を使用することができる。

【0100】

これにより、有機EL層よりなる有機ELパターン6および陰極パターン7を形成した。

【0101】

こうして作成された素子の陰極と陰極補助配線とのコンタクト特性を図5に示す。これに対し、図6は、陰極補助配線として、膜厚300 nmのCrを用いた場合の陰極と陰極補助配線とのコンタクト特性を示す。図5および図6において、コンタクト抵抗は200 μm × 200 μmあたりの抵抗値である。

【0102】

図5と図6との比較から、105 °C保持において、陰極補助配線にCrを用いた場合には、コンタクト抵抗が著しく上昇するが、Mo層、Al-Nd層、Mo層よりなる積層金属膜（Mo/Al-Nd/Mo）を適用した場合には、コンタクト抵抗は初期から低く、105 °C保持においても劣化しないことが分かる。

【0103】

またこの陰極補助配線においてはAl-Ndの比抵抗が4.5 μΩ cm程度なので、膜厚が同じとき、Crを用いた場合と比較して、配線抵抗は1/4程度に抑えられている。

【0104】

陰極補助配線としてCrの代わりに、上記のようにMoを表面に有する層を適用した場合、Mo表面に酸化層が形成される。しかしながら、Mo酸化膜が良導体であることおよびMo酸化膜中の酸素が陰極材料中に拡散しにくいため、上記の差異が生じ、上記のようにMoを表面に有する層を適用した場合には安定した低抵抗コンタクト特性が得られたものと考えられる。

【0105】

[例2]

例1の場合と同様に、上記の説明に従って、有機EL表示素子を作製した。各工程の内

10

20

30

40

50

容は、特記しない限り、例 1 と同様である。

【 0 1 0 6 】

例 2 で得られる有機 E L 表示素子の平面図を図 3 に示す。また図 3 中の B - B' の各工程における断面図を図 4 A ~ 4 C に示す。

【 0 1 0 7 】

まず、例 1 と同様にして、150 nm の ITO 膜を成膜し、陽極パターン 2 a と駆動回路接続端子 2 b とを得た。

【 0 1 0 8 】

その後、DC スパッタ法により、順に Mo - V 層、Al - Nd 層、Mo - V 層よりなる積層金属膜を成膜した。

10

【 0 1 0 9 】

この積層金属膜の膜厚は下部 Mo - V 層が 100 nm、Al - Nd 層が 300 nm、上部 Mo - V 層が 100 nm 程度とした。Mo - V 層中の V の濃度は防食性確保のため、20 原子%とした。

【 0 1 1 0 】

その後、例 1 と同様にして、フォトリソ工程でレジストをパターニングし、エッチングし、ついでレジストを剥離した。Mo - V および Al - Nd はエッチング液で一括エッチングも可能である。これにより陰極補助配線パターン 3 を形成した。

【 0 1 1 1 】

ITO 膜のパターニング工程と金属膜のパターニング工程とについて、ITO 膜と金属膜とをスパッタ法で順に成膜し、その後金属膜ついで ITO 膜の順番でパターニングすることも可能である。

20

【 0 1 1 2 】

その後、例 1 と同様にして画素開口部 4 a を有する絶縁膜パターン 4 を得た。この絶縁膜パターン 4 は、図 4 A に示すように、陰極補助配線パターン 3 上にも、陰極補助配線コントクト形成部 4 b が形成するように設けられた。

【 0 1 1 3 】

これにより、絶縁膜パターン 4 は陰極と陰極補助配線とが相接続する面積を画定し、陰極と陰極補助配線との間のコントクト抵抗のバラツキを少なくできる。またこのキュアにより、Al - Nd の抵抗を低くすることができた。

30

【 0 1 1 4 】

その後、例 1 と同様にして、陰極分離パターン 5 を得た。ついで、有機 E L 層と陰極とを蒸着により形成した。

【 0 1 1 5 】

しかしこの場合、本例では、事前に Mo - V 層の表面を清浄化した。これは Mo - V 層の表面に陰極分離層の現像時等の残渣物等が残っていたり、Mo - V の表面が酸化されたりする場合があるからである。この陰極蒸着前の清浄化処理により、コントクト抵抗自体を低く抑え、また、コントクト抵抗のバラツキを少なくでき、信頼性のあるコントクト特性を確保できる。

【 0 1 1 6 】

40

この場合、有機 E L 層の蒸着前処理として、Mo - V 層をエッチングできる CF₄ および酸素の混合ガスを用いてドライエッチングを行うことにより、Mo - V 上の汚染物質および Mo - V の表面層の一部を除去し、清浄化することが可能となる。

【 0 1 1 7 】

具体的には、プラズマ処理条件として、CF₄ 流量 50 sccm、酸素流量 160 sccm、ガスの合計圧力 6.7 Pa、1.5 kW で RIE モードのドライエッチングを 40 秒実施した。

【 0 1 1 8 】

その他 SF₆ と酸素との混合ガスを用いてもよい。いずれの場合においても、Mo - V 除去膜厚は陰極 Al の膜厚よりも少ないことが好ましい。

50

【0119】

陰極 A 1 膜厚が 200 nm だったので、Mo - V 除去膜厚は好ましい値である 30 ~ 40 nm 程度とした。

【0120】

このようにして、エッティングされた陰極補助配線コンタクト形成部 4 b を形成した。

【0121】

Mo - V 表面層を除去した後の図 3 の B - B' 断面を図 4 B に示す。図 4 B には、エッティングにより凹部分となった陰極補助配線コンタクト形成部 4 b が示されている。図中の 3' は部分的にエッティングされた補助配線パターンである。

【0122】

その後、例 1 と同様に、有機 EL 層と陰極とをマスク蒸着する前に、並行平板 RF プラズマ装置を用いて、酸素プラズマ照射を実施し、ITO 膜の表面改質を行ってもよいが、前記プラズマ処理をこの目的のために兼用することができ、合理的である。

10

【0123】

そこで、酸素プラズマ照射を省略した以外は例 1 と同様にして、有機 EL 層よりなる有機 EL パターン 6 および陰極パターン 7 を形成した。図 4 C はその様子を示す。

【0124】

このようにして、本例の場合、陰極と陰極補助配線との接続面積が、陰極補助配線コンタクト形成部 4 b で規制される。そして、これにより、陰極蒸着時のマスク位置バラツキによる、コンタクト面積のバラツキを防止できる。

20

【0125】

こうして作成された素子の陰極と陰極補助配線とのコンタクト特性は、図 7 に示すように優れた結果を示した。

【0126】

図 7 と図 5 との比較から、Mo 層と Mo - V 層との相違や厚さの相違を考慮しても、図 7 の場合の初期値の方が遙かに低く、印加電圧の影響も小さいことが分かる。すなわち、Mo または Mo 合金を含む層の表面を除去した場合のコンタクト抵抗は除去しない場合よりも初期から低く、105 保持においても劣化しないことが分かる。

【0127】

これは陰極補助配線上に形成された Mo または Mo 合金を含む層を上記ドライエッティングで除去し、清浄な Mo または Mo 合金を含む層と陰極とが接続されることにより良好なコンタクト抵抗が得られるためと考えられる。

30

【0128】

[例 3]

例 1 の場合と同様に、上記の説明に従って、有機 EL 表示素子を作製した。各工程の内容は、DC スパッタ法により、順に Mo 層、Al - Nd 層、Mo 層よりなる積層金属膜を成膜し、この積層金属膜の膜厚を、下部 Mo 層が 100 nm、Al - Nd 層が 300 nm、上部 Mo 層が 100 nm とする代わりに、DC スパッタ法により、順に Mo - Nb 層、Al - Nd 层、Mo - Nb 層よりなる積層金属膜を成膜し、この積層金属膜の膜厚を、下部 Mo - Nb 層が 100 nm、Al - Nd 層が 300 nm、上部 Mo - Nb 層が 100 nm としたこと以外は、例 1 と同様である。

40

【0129】

なお、Mo - Nb の Nb 含有量は 10 原子% であった。DC スパッタ法による積層金属膜成膜後の磷酸、酢酸、硝酸の混合水溶液よりなるエッティング液を使用したエッティングを適用する場合、Nb 含有量は 20 原子% を超えるとエッティングが困難になるため、20 原子% 以下が望ましい。

【0130】

こうして作成された素子の陰極と陰極補助配線とのコンタクト特性は補助配線に Mo 層、Al - Nd 層、Mo 層を適用した場合と同等であるが、補助配線に本実施例に示した構造を用いた場合、Mo の水分による腐食性が大幅に改善され素子の信頼性が向上する。水

50

分による腐食性の改善のためにはMo-Nb中Nbの含有量は5原子%以上が望ましい。

【0131】

【発明の効果】

以上説明したとおり、本発明によれば、低抵抗であり、陰極および駆動回路接続端子に對してその低コンタクト抵抗を維持でき、かつ、信頼性のあるコンタクト特性を有する陰極補助配線を有する有機EL表示素子、有機EL表示装置およびこのような有機EL表示素子の製造技術を提供できる。

【0132】

本発明は、情報表示パネル、自動車用の計器パネル、動画・静止画を表示させるディスプレイ等、家電製品、自動車、二輪車電装品等に使用される有機EL表示素子や有機EL表示装置として有用である。

10

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による有機EL表示素子の一例の平面図。

【図2】 図1のA-A'断面図。

【図3】 本発明による有機EL表示素子の一例の平面図。

【図4】 4A~4Bは製造工程中の図3のB-B'断面図。

【図5】 本発明によって得られた有機EL表示素子の一例の陰極と陰極補助配線との間のコンタクト特性を示すグラフ。

【図6】 従来の技術を用いた場合のコンタクト特性を示すグラフ。

【図7】 本発明によって得られた有機EL表示素子の他の一例の陰極と陰極補助配線との間のコンタクト特性を示すグラフ。

20

【図8】 従来技術を用いたコンタクト構造を示す断面図。

【図9】 本発明に係る有機EL表示素子の一例の作成順序を示すフロー図。

【図10】 逆テーパー構造を示す断面図。

【図11】 陽極エッジ9が有機EL層と接する様子を表す断面図。

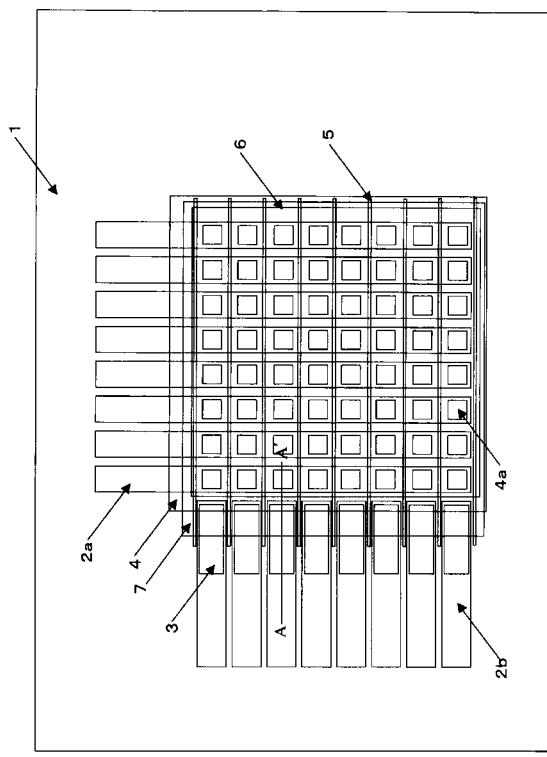
【符号の説明】

- 1 ガラス基板
- 2 a 陽極
- 2 b 駆動回路接続端子
- 3 陰極補助配線
- 3' 表面層の一部をエッチングされた陰極補助配線
- 3 a 陰極補助配線上に形成された酸化層
- 4 絶縁膜
- 4 a 画素開口部
- 4 b 絶縁膜陰極と陰極補助配線とのコンタクト形成部
- 5 陰極分離パターン
- 6 有機EL層
- 7 陰極
- 8 陰部分
- 9 陽極エッジ

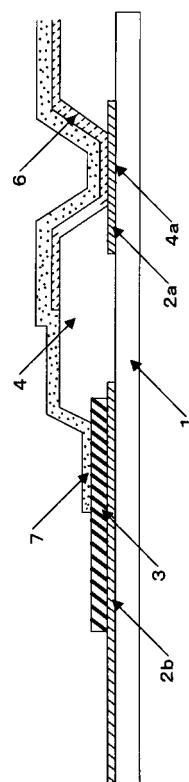
30

40

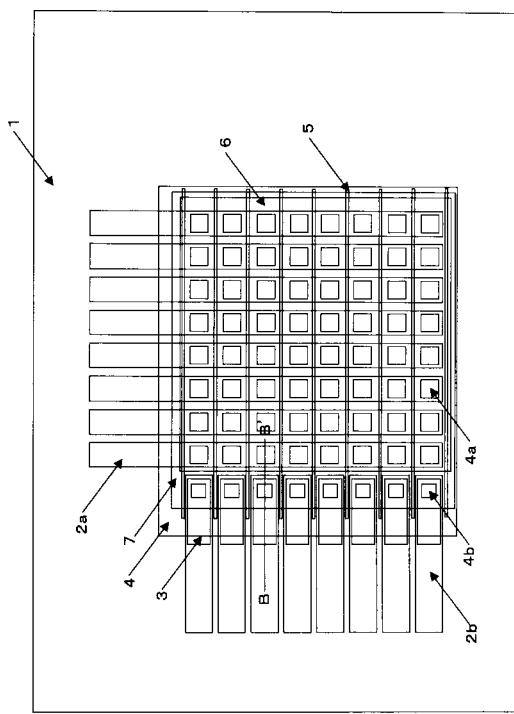
【図1】



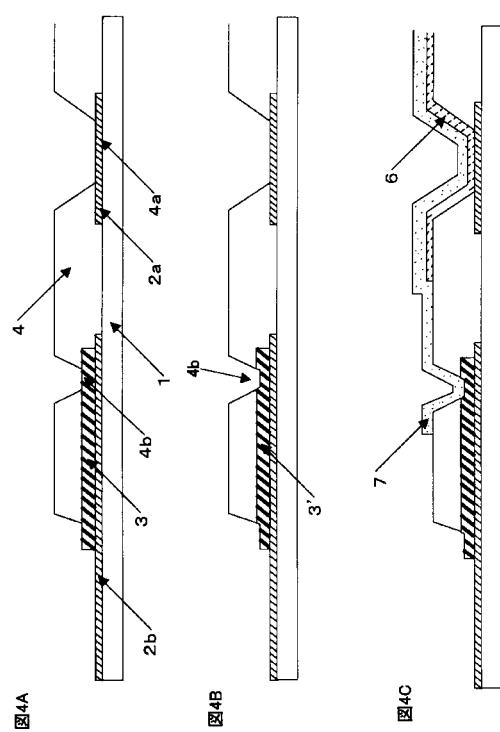
【図2】



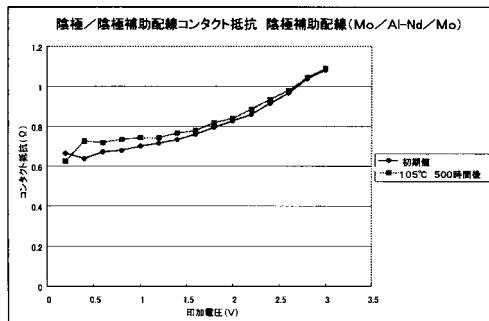
【図3】



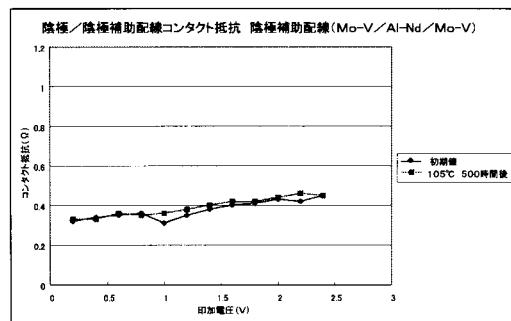
【図4】



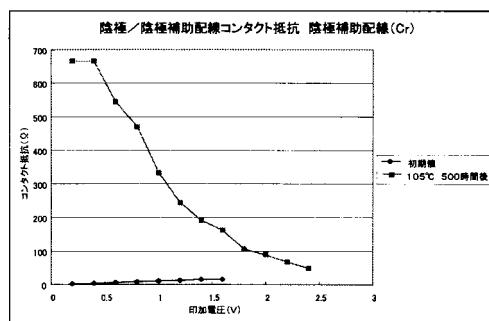
【図5】



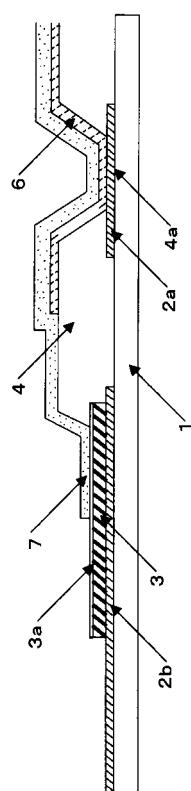
【図7】



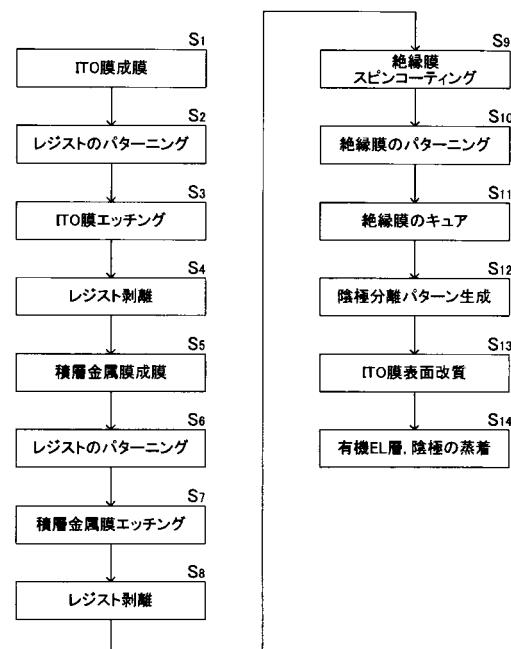
【図6】



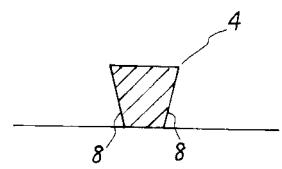
【図8】



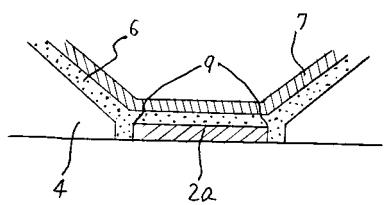
【図9】



【図10】



【図11】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開平09-306665(JP,A)
特開平05-217676(JP,A)
特開2000-082588(JP,A)
特開2000-243558(JP,A)
特開2000-294371(JP,A)
国際公開第00/060907(WO,A1)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H05B 33/06

H01L 51/50

H05B 33/10

专利名称(译)	有机电致发光显示装置，有机电致发光显示装置		
公开(公告)号	JP4271915B2	公开(公告)日	2009-06-03
申请号	JP2002252296	申请日	2002-08-30
[标]申请(专利权)人(译)	旭玻璃有限公司		
申请(专利权)人(译)	光王公司 旭玻璃有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	光王公司		
[标]发明人	中村伸宏		
发明人	中村 伸宏		
IPC分类号	H05B33/06 H05B33/10 H01L51/50 G09F9/30 H01L27/32 H01L51/52		
CPC分类号	H01L27/3288 H01L51/5221		
FI分类号	H05B33/06 H05B33/10 H05B33/14.A G09F9/30.365.Z G09F9/30.365 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K007/AB05 3K007/AB18 3K007/BA06 3K007/BB07 3K007/CC05 3K007/DB03 3K007/FA02 3K107 /AA01 3K107/BB01 3K107/BB08 3K107/CC11 3K107/CC22 3K107/CC33 3K107/DD26 3K107/DD38 3K107/DD39 3K107/DD44Y 3K107/DD44Z 3K107/EE02 3K107/FF00 3K107/FF14 3K107/GG13 3K107 /GG23 5C094/AA21 5C094/AA31 5C094/BA27 5C094/EA10 5C094/GA10 5C094/HA05		
审查员(译)	松田敬之		
优先权	2002109682 2002-04-11 JP		
其他公开文献	JP2005108437A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种有机电致发光（EL）显示元件和有机EL显示装置，其具有能够保持对阴极的低接触电阻的阴极辅助线和具有低电阻且具有可靠接触特性的驱动电路连接端子和制造有机EL显示元件的技术。
 ŽSOLUTION：该有机EL显示元件包括阳极，驱动电路连接端子，有机EL层和阴极。设置在驱动电路连接端子和阴极之间的阴极辅助线具有由Mo或Mo合金构成的表面层。Ž

【图 3】

